液晶分子の配向性と 配向膜表面の結晶性との相関

日産化学工業株式会社・電子材料研究所 〇酒井隆宏・石津谷正英・志田啓文・筒井皇晶・後藤耕平

(財)高輝度光科学研究センター・利用研究促進部門 I 広沢一郎



ON

電場

■ 液晶ディスプレイ(LCD)

<u>一方向に揃った(配向した)液晶分子</u>を
 電圧により動かすことで表示



液晶分子

■液晶配向と表示品質

• 液晶分子の配向が乱れると表示品質が悪化。



OFF

液晶分子



■ 液晶の配向制御

● 液晶配向膜(高分子)を布で一方向に擦る(ラビング処理する)ことで実現





- 従来の研究
 - 反射型エリプソメトリー
 - 非線形光学効果(SHG, SFG)
 - 偏光FT-IR
 - 軟X線吸収測定(NEXAFS)

従来の研究は配向膜の分子配向に注目

■材料開発の中で





















■ 屈折率と全反射

可視光領域では空気よりも物質の方が<u>屈折率大</u>



原理IV ~ 表面選択性~

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

空気 屈折率と全反射 空気 可視光領域では 物質 物質 物質 空気よりも物質の方が屈折率大 屈折率大 屈折率小 屈折率小 X線領域では $X線(\thetaが大)$ $X線(\theta が小)$ 可視光 空気よりも物質の方が屈折率小 非常に小さな角度で空気からX線を入射することで全反射が起こる X線全反射により物質表面近傍のみを測定可能 これが微小角入射X線散乱(Grazing-Incidence X-ray Scattering) ■ 表面と全体との区別法 配向膜 非常に小さな角度でX線を入射(配向膜表面で全反射) Si 基板 ───>配向膜表面近傍の情報 ● 大きな角度で×線を入射(配向膜は透過、基板界面で全反射) ──>配向膜全体の情報 基板 Si 膜表面と膜全体の情報を区別できる **P8**

測定 ~ 試料と測定~

■ 試料

	液晶配向性	予測される結晶性		
SP-PI1	0	0		
SP-PI2	Δ	Δ		
SP-PI3	Ø	0		
SP-PI4	×	×		





- 膜厚:1000Å
- 基板:Siウエハー

配向性の良いものは結晶性が高いと予測

■ 測定

- ビームライン: BL19B2
- X線エネルギー: 10keV
- 入射角: 0.12°(表面のみ)
 0.16°(膜全体)



配向膜全体 ~ バルクの結晶性~

P10

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.



●全ての配向膜にハロー以外の鋭いピークが存在する →膜全体を観察すると全ての配向膜が結晶性を持つ

配向膜全体で見た結晶性と液晶配向性には相関無し

配向膜表面 I ~ 配向性悪い~

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.



●SP-PI4(配向性×)はハロー(鈍いピーク)のみ

P11

●SP-PI2(配向性ム)は水平方向にのみ鋭いピークが出現

・配向性の最も悪いSP-PI4は表面に結晶性を持たない

・配向性の少し悪いSP-PI2は水平方向にのみ結晶性がある

配向膜表面II~配向性良い~

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.



まとめ ~ 表面結晶性と液晶配向性~

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

	表面の結晶性		液晶配向性
	ラビング後		
	水平方向	垂直方向	
SP-PI1	0	0	0
SP-PI2	0	×	Δ
SP-PI3	Ø	0	Ø
SP-PI4	×	×	×

配向膜の表面結晶性と液晶配向性との相関が明らかとなった

配向性の良い液晶配向膜とは

①表面にラビングに対して水平方向の結晶性を持つ
 ②表面にラビングに対して垂直方向の結晶性を持つ
 ③表面にラビングに対して水平方向の結晶性をより強く持つ

本実験により次世代液晶配向膜の開発が加速



■ 面内異方性測定

- 結晶性を示す鋭いピークに着目(散乱角θpを固定)
- 試料を基板面内で回転させ、ピーク強度の試料回転角依存を測定

